

GP 1756
4/64

PATENT
ATTORNEY DOCKET NO. 03850/010001
PATENT APPLICATION NO. 09/934,262

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Oliver KIENZLE et al. Art Unit: 1756
Serial No.: 09/934,262 Examiner:
Filed : August 21, 2001
Title : APPARATUS AND METHOD FOR EXPOSING A RADIATION
SENSITIVE LAYER BY MEANS OF CHARGED PARTICLES AS WELL
AS A MASK FOR THIS PURPOSE

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

RECEIVED
JAN 22 2002
TC 1700

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT(S) UNDER 35 U.S.C. 119

Applicant hereby confirms his claim of priority under 35 U.S.C. 119 from German

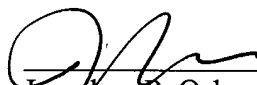
Application No. 100 41 040.5 filed August 22, 2000. A certified copy of the application from
which priority is claimed is submitted herewith.

Please charge any fees due in this respect to Deposit Account No. 50-0591, referencing
03850/010001.

Respectfully submitted,

Date:

12/11/01


Jonathan P. Osha
Reg. No. 33,986

ROSENTHAL & OSHA L.L.P.

1221 McKinney, Suite 2800

Houston, TX 77010

Telephone: 713/228-8600

Facsimile: 713/228-8778

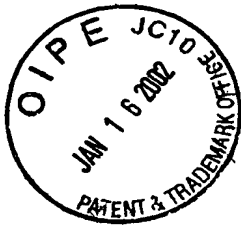
Date of Deposit: December 11, 2001

I hereby certify under 37 CFR 1.8(a) that this
correspondence is being deposited with the United States
Postal Service as **first class mail** with sufficient postage
on the date indicated above and is addressed to the
Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C.
20231.



Tawana L. Garcia

#4



RECEIVED
JAN 22 2002
TC 1700

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 100 41 040.5

Anmeldetag: 22. August 2000

Anmelder/Inhaber: Fa. Carl Zeiss, Heidenheim an der Brenz/DE

Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Belichtung einer strahlungsempfindlichen Schicht mittels geladener Teilchen sowie Maske hierfür

IPC: G 03 F //20

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 14. August 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Wehner

DIEHL · GLAESER HITL & PARTNER

GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS

Patentanwälte · Augustenstrasse 46 · D - 80333 München

Dr. Hermann O. Th. Diehl · Diplom-Physiker
Joachim W. Glaeser · Diplom-Ingenieur
Dr. Elmar Hiltl · Diplom-Chemiker
Dr. Elisabeth Engelhard · Diplom-Biologin
Dr. Frank Schorr · Diplom-Physiker

In Kooperation mit Diehl & Partner AG
CH - 7513 Silvaplana · Schweiz

Patentanwälte · European Patent Attorneys
München · Hamburg

21. August 2000

Neue deutsche Patentanmeldung

Z8435-DE

Carl Zeiss

D-89518 Heidenheim (Brenz)

DEUTSCHLAND

**VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BELICHTUNG EINER
STRAHLUNGSEMPFINDLICHEN SCHICHT MITTELS GELADENER TEILCHEN
SOWIE MASKE HIERFÜR**

Kanzlei · Office: München

U:\ANMELDER\ZEISS\Z8410-DE\DECKBLAT.DOC

Telefon · Telephone
(089) 17 86 36-0

Telefax · Facsimile
(089) 1 78 40 33
(089) 1 78 40 34

EMAIL-Adresse:
info@diehl.ccn.de

Anschrift · Address
Augustenstrasse 46
D - 80333 München

Postanschrift · Mailing address
P.O. Box 34 01 15
D - 80098 München

Zeiss

Z8435-DE

5 **VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BELICHTUNG EINER STRAHLUNGSEMP-
FINDLICHEN SCHICHT MITTELS GELADENER TEILCHEN SOWIE MASKE
HIERFÜR**

10 Die Erfindung betrifft den Bereich der Herstellung von
Bauelementen mittels lithografischer Verfahren und
insbesondere die Belichtung strahlungsempfindlicher Schichten
mittels geladener Teilchen, insbesondere eines
Elektronenstrahls.

15 Bei den Bauelementen handelt es sich vornehmlich um stark mi-
niaturisierte Bauelemente, wie etwa mikromechanische
Strukturen oder integrierte Schaltungen (ICs). Im Fall der
integrierten Schaltung enthält eine Maske (engl.: "reticle")
20 ein Schaltungsmuster, das einer einzelnen Schicht der auf
einem geeigneten Substrat, beispielsweise einem Silizium-
Wafer, auszubildenden Schaltung entspricht. Zur Abbildung des
Musters auf einem Zielbereich (engl.: "die") des Substrats
wird letzteres zunächst mit einer strahlungsempfindlichen
25 Schicht (engl.: "resist") bedeckt. Sodann wird die
strahlungsempfindliche Schicht exponiert bzw. belichtet,
indem das Muster der Maske mittels geladener Teilchen auf die
strahlungsempfindliche Schicht abgebildet wird. Die
strahlungsempfindliche Schicht wird darauf entwickelt, und es
30 werden entweder die belichteten bzw. exponierten oder die
unbelichteten bzw. nicht exponierten Bereiche der belichteten
Schicht abgetragen. Die verbleibende Struktur der
strahlungsempfindlichen Schicht dient dann als Maske in bei-
spielsweise einem Ätzschritt, einem
35 Ionenimplantationsschritt, einem Materialabscheidungsschritt
oder ähnlichem.

Geladene Teilchen, beispielsweise Elektronen oder Ionen, werden hierbei eingesetzt, um derart kleine Strukturen herstellen zu können, deren Fertigung mittels herkömmlicher lichtoptischer Abbildung auf Grund der dort bestehenden Beugungsbeschränkung nicht oder nur unter Schwierigkeiten herstellbar sind.

Als Verfahren, das mit einem Elektronenstrahl zur Belichtung der strahlungsempfindlichen Schicht arbeitet, ist das SCALPEL-Verfahren (Scattering with Angular Limitation in "Projection Electron-beam Lithography") bekannt. Dieses Verfahren ist beschrieben in dem Weisbuch "SCALPEL: A Projection Electron-Beam Approach to Sub-Optical Lithography", Technology Review, Dezember 1999, von J. A. Liddle, Lloyd R. Harriott, A.E. Novembre und W. K. Waskiewicz, Bell Laboratories, Lucent Technologies, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, USA. Dieses Dokument wird hier durch Inbezugnahme vollumfänglich in die Beschreibung einbezogen. Weiterhin betreffen die Patentedokumente US 5 079 112, 5 130 213, 5 260 151, 5 376 505, US 5 258 246, US 5 316 879 sowie EP 0 953 876 A2 und EP 0 969 326 A2 das SCALPEL-Verfahren. Diese vorangehend genannten Dokumente werden ebenfalls durch Inbezugnahme vollumfänglich hier in diese Beschreibung aufgenommen.

Das SCALPEL-Verfahren wird nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 1 erläutert.

In Fig. 1 ist schematisch eine Maske 1 dargestellt, die zur Belichtung einer strahlungsempfindlichen Schicht auf einem Substrat 3 mittels eines Elektronenstrahls geeignet ist. Die Maske umfasst tragende Stege 7, an welchen eine Membranschicht 5 angebracht ist, die für die Elektronen relativ transparent ist. Das auf das Substrat 3 abzubildende Muster ist durch auf der relativ transparenten Membranschicht

vorgesehene Streubereiche 9 gebildet. Lediglich die Membranschicht 5 und nicht die Streubereiche 9 durchsetzende Elektronenstrahlen 11 und 12 durchsetzen die Maske 1 im Wesentlichen ungestreut und im wesentlichen geradlinig, oder mit einem vergleichsweise kleinen Streuwinkel, während Elektronenstrahlen 13, welche die Membranschicht 5 und die Streubereiche 9 durchsetzen, in den Streubereichen 9 aus ihrer ursprünglichen Richtung mit einem größeren Streuwinkel abgelenkt werden. Die Elektronenstrahlen 11, 12, 13 verlaufen durch ein elektromagnetisches oder/und elektrostatisches Projektionslinsensystem 15 und werden durch dieses derart abgelenkt, dass die ungestreuten Elektronenstrahlen 11, 12 eine in einer Blende 17 vorgesehene Öffnung durchlaufen, während die mit größeren Streuwinkeln gestreuten Elektronen 13 von der Blende 17 absorbiert werden. Nach der Blende 17 durchlaufen die mit den kleineren Streuwinkeln gestreuten Elektronenstrahlen 11, 12 ein weiteres Projektionslinsensystem 19, welches die Strahlen 11, 12 zur Abbildung des Musters 9 auf das Substrat 3 fokussiert.

Das auf die Maske 1 fallende Elektronenfeld enthält auch Strahlen 21, die nicht wie die vorangehend beschriebenen Strahlen 11, 12, 13 in die Zwischenräume zwischen den Stegen 7 fallen, sondern die Stege 7 treffen. Aufgrund der Dicke der Stege 7 werden die Strahlen 21 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gestreut als die Strahlen 11 und 12, die lediglich die Membranschicht 5 durchsetzen. Deshalb werden die Bereiche der Maske, welche in ihrer Projektion entlang des Elektronenfelds unterhalb der Stege liegen, nicht für die Bildung des Musters verwendet. Entsprechend sollen Strahlen 21, die die Stege 7 und die Membranschicht ungestreut durchsetzen, auch nicht durch die Blende 17 auf das Substrat 3 gelangen.

Hierzu schlägt die EP 0 969 326 A2 einen räumlich begrenzten Elektronenstrahl vor, dessen Strahlquerschnitt in der Ebene

der Maske so begrenzt ist, dass er die Maske an Zwischenräumen zwischen benachbarten Stegen durchsetzt und die Stege selbst nicht berührt. Dieser räumlich begrenzte Strahl wird dann relativ zur Maske in Erstreckungsrichtung der Stege verfahren, um die gesamten für die Bildung des 5 Musters verwendeten Bereiche der Maske abzutasten. Im Hinblick auf die räumliche Definition des Strahlquerschnitts schlägt die EP 0 969 326 A2 beispielsweise die Verwendung von Blenden vor. Hierdurch ist es zwar möglich, den Strahl so zu 10 formen, dass sein Strahlquerschnitt genau der lichten Weite zwischen benachbarten Stegen entspricht und somit eine Streuung der Elektronen an den Stegen vermeidbar ist, sofern der Strahl selbst bezüglich der Maske mit ausreichender Präzision positioniert ist und die Abtastbewegung des Strahls 15 relativ zur Maske ebenfalls so präzise erfolgt, dass das Strahlenfeld die Stege nicht berührt. Zudem werden die Bereiche zwischen den Stegen der Maske auf aneinanderliegende Streifen auf dem zu belichtenden Substrat abgebildet. Positionsungenauigkeiten bei der Abtastung der Maske können 20 dann zu Unterbelichtungen bzw. Doppelbelichtungen auf dem Substrat führen.

Aus dem Stand der Technik sind allerdings keine Maßnahmen bekannt, die eine solche Strahlführung mit ausreichender Präzision ermöglichen. 25

Es ist demgemäß eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, um unter Verwendung einer Maske der vorangehend geschilderten Art den 30 Strahl geladener Teilchen zur Abbildung des Musters auf das Substrat so zu führen, dass der Strahl möglichst entlang vorbestimmter Bahnen über die Maske bewegt wird. Weiter ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Maske der eingangs geschilderten Art derart weiterzubilden, dass eine 35 solche Vorrichtung und ein solches Verfahren ermöglicht werden.

Die Erfindung geht dabei aus von einer Maske, welche eine Membranschicht aus einem ersten Material, das Muster bildende Streubereiche aus einem geladene Teilchen stärker als die Membranschicht streuenden zweiten Material und eine Mehrzahl von mit Abstand voneinander angeordneten, sich geradlinig erstreckenden und die Membranschicht samt der Streubereiche tragenden Stützstegen umfasst.

Ferner geht die Erfindung aus von einer Projektionsvorrichtung zum Abbilden des Musters der Maske auf ein mit einer strahlungsempfindlichen Schicht versehenes Substrat mittels eines Strahls geladener Teilchen, wobei die Projektionsvorrichtung eine Strahlformungseinrichtung zum Erzeugen des Projektionsstrahls mit einem vorbestimmten Projektionsstrahlquerschnitt in der Maskenebene sowie eine Positionier-Bewegungseinrichtung umfasst, um den Projektionsstrahlquerschnitt der Maskenebene entlang einer vorbestimmten Bahn parallel zu einer Erstreckungsrichtung der Stege über die Maske zu bewegen.

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, an der Maske gezielt Markierungsbereiche vorzusehen, welche durch ein Material gebildet sind, welches sich hinsichtlich seiner Wechselwirkung mit den geladenen Teilchen von dem Material der Membranschicht und dem das Muster bildenden Material unterscheidet. Diese unterschiedliche, für das Markierungsmaterial charakteristische Wechselwirkung mit den geladenen Teilchen ist durch einen geeigneten Sensor nachweisbar, so dass der Sensor ein Messsignal abgibt, welches von der Anzahl der geladenen Teilchen abhängt, die den Markierungsbereich treffen. Werden nun die Markierungsbereiche an geeigneten Orten der Maske angebracht, kann das Messsignal dazu verwendet werden, die Position des Projektionsstrahlquerschnitts in der Maskenebene zu bestimmen

und eine "Führung" für die Bewegung des Projektionsstrahlquerschnitts relativ zu der Maske zu bilden.

Die für das Markierungsmaterial charakteristische und diese von dem Material der Membranschicht und dem Material der Streubereiche unterscheidende Wechselwirkung kann in einer anderen bzw. verschiedenen Streuwirkung, Reflexionswirkung oder Absorptionswirkung für die geladenen Teilchen liegen, oder die unterscheidende Wechselwirkung kann auch in einer anderen oder verschiedenen Emissionswirkung für sekundäre Teilchen liegen, wie etwa Röntgenemission oder Angerelektronenemission. Wesentlich ist lediglich, dass diese unterscheidende Wechselwirkung durch ein geeignetes Messverfahren nachweisbar ist, so dass hierfür jeder geeignete und nachweisbare physikalische Effekt in Betracht kommt. Vorteilhafterweise ist diese charakteristische Wechselwirkung mittels eines Auger-Elektronendetektors, eines Rückstreuelektronendetektors, eines Röntgenstrahlungsdetektors oder eines Fluoreszenzstrahlungsdetektors nachweisbar. Ein solcher Detektor kann auf der der Strahlformungseinrichtung zugewandten Seite der Maske aber auch auf der von der Strahlformungseinrichtung abgewandten Seite der Maske angeordnet sein.

Vorteilhafterweise ist der Markierungsbereich durch eine Schicht aus dem Markierungsmaterial gebildet, welche auf der Stirnseite des Stegs aufgebracht ist, die von der Membranschicht abgewandt ist. Diese Ausführung ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Stege auf der der Strahlformungseinrichtung zugewandten Seite der Maske angeordnet sind.

Diese Ausführung ist ferner dann vorteilhaft, wenn die Stege durch ein Ätzverfahren aus einem Substrat gebildet werden, wobei vor dem Ätzen auf dem Substrat eine die Geometrie der Stege wiedergebende Maske aufgebracht wurde. Bei geeigneter

Wahl des Maskenmaterials kann dieses nach dem Herausätzen der Stege auf diesen verbleiben, um dann weiterhin als Markierungsmaterial zu wirken.

5 Alternativ hierzu kann der Markierungsbereich auch durch eine zwischen der Membranschicht und dem Steg angeordnete Markierungsschicht gebildet sein. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Stege durch ein Ätzverfahren hergestellt werden, bei welchem zwischen der Membranschicht
10 und dem Material, aus dem die Stege zu ätzen sind, eine Ätz-Stopp-Schicht vorgesehen ist. Diese Ätz-Stopp-Schicht wird nach dem Ätzvorgang zur Bildung der Stege im Zwischenraum zwischen den Stegen entfernt, bleibt jedoch zwischen Stegen und Membranschicht bestehen. Bei geeigneter Wahl des
15 Materials für die Ätz-Stopp-Schicht können die verbleibenden Bereiche der Ätz-Stopp-Schicht zwischen den Stegen und der Membranschicht dann nachfolgend als Markierungsbereiche verwendet werden.

20 Alternativ hierzu können die Markierungsbereiche jedoch auch auf der den Stegen abgewandten Seite der Membranschicht ausgebildet sein. Diese Ausführung ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Stege selbst auf der Seite der Maske angeordnet sind, die von der Strahlformungseinrichtung
25 abgewandt ist.

Eine besonders einfache Art der Strahlführung ergibt sich vorteilhafterweise dann, wenn der Markierungsbereich durch den Steg selbst gebildet ist.

30 Unter einem ersten weiteren Aspekt der Erfindung ist vorgesehen, dass die Positionier-Bewegungseinrichtung auf das Messsignal anspricht, um Abweichungen von der vorbestimmten Bahn zu reduzieren. Es ist dann möglich, den
35 Projektionsstrahlquerschnitt so über die Maske zu führen,

dass möglichst keine geladenen Teilchen des Projektionsstrahls unerwünschterweise auf die Stege treffen.

Hierbei ist es vorteilhaft, dass der Projektionsstrahlquerschnitt in Richtung quer zur Erstreckungsrichtung der Stege eine Breite aufweist, die im wesentlichen der lichten Weite zwischen benachbarten Stegen entspricht. Ist dann insbesondere der Markierungsbereich so angeordnet, dass er, gesehen in Strahlrichtung, mit den Stegen zusammenfällt, so registriert der Sensor im Wesentlichen keine Wechselwirkung der geladenen Teilchen mit dem Markierungsbereich, wenn der Projektionsstrahlquerschnitt auf der vorbestimmten Bahn relativ zur Maske positioniert ist. Sobald der Strahl von seiner vorbestimmten Bahn abweicht, wird der Projektionsstrahlquerschnitt dann den Markierungsbereich berühren und die hierfür charakteristische Wechselwirkung mit dem Markierungsmaterial erzeugen, welche von dem Sensor nachweisbar ist. Die Positionier-Bewegungseinrichtung ist dann in der Lage, eine entsprechende Korrektur an der Bahn des Strahls hin zu der vorbestimmten Bahn durchzuführen.

Vorteilhafterweise sind zwei verschiedene Arten von Markierungsbereichen ausgebildet, welche durch unterschiedliche Markierungsmaterialien mit durch den Sensor unterscheidbarer Wechselwirkung mit den geladenen Teilchen gebildet sind. Wird die eine Art von Markierungsbereich in Projektion in Strahlrichtung über dem einen Steg ausgebildet und die andere Art von Markierungsbereich in Projektion über dem hierzu benachbarten Steg ausgebildet, so kann bei zwischen diesen beiden Stegen bewegtem Strahl unterschieden werden, ob die Bahn in die Richtung des einen Steges oder in die Richtung des anderen Steges von der vorbestimmten Bahn abweicht, so dass die Positionier-Bewegungseinrichtung eine entsprechend gerichtete Korrektur besser durchführen kann.

Vorteilhafterweise erzeugt die Strahlformungseinrichtung neben dem Projektionsstrahl noch wenigstens einen Positionierungshilfsstrahl, der zur Wechselwirkung mit dem Markierungsbereich vorgesehen ist. Bei ordnungsgemäß positioniertem Projektionsstrahlquerschnitt zwischen benachbarten Stegen ist der Hilfsstrahlquerschnitt dann relativ zu dem Projektionsstrahlquerschnitt derart angeordnet, dass er auf einen Steg fällt. Der Markierungsbereich ist dann vorteilhafterweise in Projektion in Strahlrichtung über den Stegen angeordnet, so dass die Wechselwirkung mit dem Markierungsmaterial bei ordnungsgemäß positioniertem Projektionsstrahl nicht mit dem Projektionsstrahl selbst, sondern durch den Hilfsstrahl erfolgt. Die Position des Projektionsstrahls kann damit selbst dann erfasst werden, wenn dieser nicht von seiner vorbestimmten Bahn abweicht. Andererseits trifft der Hilfsstrahl in einem Bereich auf die Maske, welche für die Abbildung des Musters auf das Substrat nicht verwendet wird. Aus diesem Bereich werden die geladenen Teilchen des Hilfsstrahls durch den Steg oder/und den in dessen Projektion vorgesehenen Markierungsbereich gestreut und tragen aus diesem Grund ebenfalls im wesentlichen nicht oder nur geringfügig zur Belichtung der strahlungsempfindlichen Schicht bei.

Der Positionierungshilfsstrahl weist vorteilhafterweise eine Gestalt auf, die sich, gesehen in eine Richtung quer zur Erstreckungsrichtung der vorbestimmten Bahn, kontinuierlich verjüngt. Hierdurch trifft bei zunehmender Abweichung der Bahn des Projektionsstrahlquerschnitts von seiner vorbestimmten Bahn ein zunehmend größerer Bereich des Positionierungshilfsstrahls auf den Markierungsbereich, so dass die Stärke des Messsignals mit zunehmender Abweichung der Bahn von der vorbestimmten Bahn zu- bzw. abnimmt. Hierdurch ist das Messsignal zur Korrektur der Bahn durch die Positionier-Bewegungseinrichtung besonders gut geeignet.

Vorteilhafterweise erzeugt die Strahlformungseinrichtung zwei Positionierungshilfsstrahlen, deren Abstand in Maskenebene derart bemessen ist, dass beide Hilfsstrahlen bei
 5 ordnungsgemäß positioniertem Projektionsstrahl auf jeweils verschiedene Stege, nicht jedoch in den Bereich zwischen den Stegen treffen.

Insbesondere hierbei ist es vorteilhaft, wenn der
 10 Markierungsbereich, gesehen in Strahlrichtung, innerhalb der projizierten Fläche des Stegs und mit einem vorbestimmten Abstand von deren Rändern angeordnet ist. Dann kann, insbesondere in Verbindung mit dem sich verjüngenden Hilfsstrahlquerschnitt, die tatsächliche Position des
 15 Projektionsstrahls besonders präzise erfasst werden.

Alternativ hierzu ist es auch möglich, den Markierungsbereich zwischen benachbarten Stegen und nahe einem der beiden benachbarten Stege anzuordnen. Hierbei sollte der
 20 Markierungsbereich allerdings die Zahl der ungestreut durch die Maske tretenden geladenen Teilchen nur unwesentlich reduzieren. In Verbindung mit einem Projektionsstrahlquerschnitt, der sich in einem Bereich nahe
 25 der Stege hin zu den Stegen verjüngt, ist damit auch mit dem zwischen den Stegen angeordneten Markierungsbereich eine Erfassung der Position des Projektionsstrahls möglich.

Vorteilhafterweise ist ferner ein Maskierungsbereich vorgesehen, der, gesehen in Projektion parallel zu dem
 30 Teilchenstrahl, mit dem Markierungsbereich wenigstens teilweise überlappt. Aufgabe des Maskierungsbereichs ist es, zu verhindern, dass geladene Teilchen, welche durch den Markierungsbereich geringfügig gestreut wurden, soweit zu streuen, dass sie nicht auf die strahlungsempfindliche
 35 Schicht abgebildet werden. Geladene Teilchen, die durch die Wechselwirkung mit dem Markierungsbereich nicht gestreut oder

nur um einen kleinen Streuwinkel gestreut wurden, erhalten also durch die Wechselwirkung mit dem Maskierungsbereich einen so großen Streuwinkel, dass sie nicht so auf die zu belichtende Schicht abgebildet werden, wie dies mit den geladenen Teilchen geschieht, die lediglich die Membranschicht durchsetzten. Hierzu ist der Maskierungsbereich vorzugsweise aus einem Material gebildet, welches die geladenen Teilchen stärker streut als die Membranschicht oder/und das Maskierungsmaterial oder/und der Stützsteg.

Hierbei ist es weiter bevorzugt, dass das Material des Maskierungsbereichs das Material des Streubereichs umfasst, insbesondere können Maskierungsbereiche und Streubereiche in einem gemeinsamen Fertigungsschritt der Maske hergestellt werden.

Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigt:

Figur 1 eine Projektionsvorrichtung gemäß dem Stand der Technik;

Figur 2 eine Darstellung einer erfindungsgemäßen Maske in Draufsicht sowie eine Erläuterung von Richtungen der Strahlführung;

Figur 3 eine Vergrößerung der Figur 2 zur Erläuterung der Führung eines Projektionsstrahlquerschnitts entlang einer vorbestimmten Bahn;

Figur 4 eine erfindungsgemäße Projektionsvorrichtung;

Figur 5 eine Darstellung der Anordnung eines bei der Projektionsvorrichtung der Figur 4 verwendeten

Projektionsstrahlquerschnitts bezüglich
Markierungsbereichen;

- Figur 6 eine Variante der Erfindung mit Positionierungshilfsstrahl;

Figur 7 eine Variante der in Figur 4 dargestellten Maske;

Figur 8 eine weitere Ausführungsform der Maske zur Verwendung mit Positionierungshilfsstrahl gemäß Figur 6;

Figur 9 eine Variante der Maske zur Verwendung mit Positionierungshilfsstrahl gemäß Figur 6;

Figur 10 eine weitere Variante der Erfindung mit Positionierungshilfsstrahl;

Figur 11 eine Ausführungsform der Erfindung zum Erfassen eines Bahnendes;

Figur 12 eine Variante der in Figur 11 dargestellten Ausführungsform zur Erfassung des Bahnendes und

Figur 13 eine Variante der in Figur 5 dargestellten Ausführungsform.

Figur 14 eine weitere Variante der in Figur 4 gezeigten Maske.

Der Aufbau einer erfindungsgemäßen Maske 31 ist aus den Figuren 2 und 4 ersichtlich, wobei Figur 2 die Maske in Draufsicht und Figur 4 die Maske 31 im Querschnitt entlang einer Linie IV-IV in Figur 2 darstellt.

Die Maske 31 umfasst ein ebenes regelmäßiges und rechtwinkliges Gerüst aus längsverlaufenden Stegen 33 und

quer hierzu sich erstreckenden Stegen 35. Die Stege 33 sind mit einem regelmäßigen Abstand a von beispielsweise 1.1 mm bis 1.5 mm voneinander angeordnet. Die Stege 35 sind mit einem Abstand b voneinander angeordnet, der größer ist als der Abstand a der Stege 33 voneinander. Das Gerüst aus den Stegen 33, 35 trägt eine Membranschicht 37, welche Elektronen vergleichsweise wenig streut. Das Muster der Maske 31 wird durch Streubereiche 39 gebildet, die zwischen den Stegen 33, 35 auf der Membranschicht 37 angeordnet sind.

Auf die Maske 31 ist, wie aus Figur 4 ersichtlich, ein durch eine nicht dargestellte Elektronenstrahlquelle erzeugter Elektronenstrahl 41 mit beispielsweise einer Energie von 100 keV gerichtet, dessen Strahlquerschnitt 43 (vergl. Figur 3) in der Ebene der Maske 31 durch eine Strahlformungseinrichtung 45 bestimmt ist. Die Strahlformungseinrichtung 45 kann beispielsweise durch eine Blendenvorrichtung gebildet sein. Wie aus Figur 3 ersichtlich, ist der Projektionsstrahlquerschnitt 43 trapezförmig und umfasst einen zentralen rechteckigen Bereich 45 und zwei an gegenüberliegenden Seiten des Rechtecks 45 angrenzende dreieckige Bereiche 47.

Eine Positionier-Bewegungseinrichtung bewegt den Strahlquerschnitt 43 zwischen benachbarten Stegen 33 in eine Richtung A (Figur 2) geradlinig entlang von vorbestimmten Bahnen 49. Eine solche vorbestimmte Bahn 49 beginnt an einem Punkt 51 und endet an einem Punkt 53 derart, dass von dem Projektionsstrahlquerschnitt 43 der gesamte Bereich zwischen benachbarten Stegen 35 überstrichen wird. Ist der Projektionsstrahlquerschnitt an dem Punkt 53 angelangt, wird der Projektionsstrahl über die Elektronenstrahlquelle abgeschaltet, und der Projektionsstrahlquerschnitt überspringt einen Steg 33 in eine Richtung B quer zur Erstreckungsrichtung der Stege 33. Sodann gelangt er zu einem neuen Startpunkt 51 zwischen dem nächsten benachbarten Steg-

paar 33 und wird dann wiederum gleichförmig zu einem weiteren Endpunkt 53 bewegt. Auf diese Weise werden nach und nach sämtliche Bereiche der Membranschicht 37 zwischen den Stegen 33, 35 durch den Strahlquerschnitt 43 abgetastet.

5

Die Positionier-Bewegungseinrichtung umfasst eine elektronenoptische Vorrichtung, die die Ablenkung des Strahls in Richtung A durchführt, sowie einen Antrieb 55, der die Maske relativ zu der Elektronenoptik gleichförmig in Richtung
10 B bewegt. Ferner umfasst die Positionier-Bewegungseinrichtung eine weitere elektronenoptische Komponente 57, welche den Projektionsstrahl 41 ebenfalls in Richtung B derart ablenkt, dass sich der Projektionsstrahlquerschnitt 43 entlang der vorbestimmten Bahnen 49 zwischen den Stegen 33 und während
15 der durch den Motor 55 getriebenen kontinuierlichen Bewegung der Maske 31 relativ zu der Elektronenoptik bewegt.

20

Weitere Details zu der Gestalt des Projektionsstrahlquerschnitts und der Maske 31 sowie deren Stegstruktur 33, 35 können dem oben genannten Weisbuch entnommen werden. Die Positionier-Bewegungseinrichtung weist ferner eine Steuereinrichtung 58 auf, welche einen Ablenksignalgenerator 59 umfasst, der die elektronenoptische Komponente 57 zur Ablenkung des Projektionsstrahls 41 in die Richtungen A und B
25 ansteuert.

25

30

35

Die Spitzen der beiden dreieckigen Bereiche 47 des Projektionsstrahlquerschnitts 43 weisen bei der hier beschriebenen Ausführungsform in der Maskenebene einen Abstand voneinander auf, der einer lichten Weite d zwischen den mit dem Abstand a voneinander angeordneten Stegen 33 entspricht. Bei ordnungsgemäß auf der vorbestimmten Bahn 49 angeordnetem Projektionsstrahlquerschnitt mit Strahlschwerpunkt O (vergleiche Figur 5) treffen dann keine
Elektronen des Projektionsstrahls 41 auf die Stege 33, wie dies in Figur 4 durch den Strahl 41 in durchgezogener Linie

und in Figur 5 mit dem oberen Strahlquerschnitt dargestellt ist. Weicht der Projektionsstrahlquerschnitt von seiner vorbestimmten Bahn 49 um eine Strecke Δy ab, so treffen Elektronen aus einem der dreieckigen Bereiche 47 auf einen
 5 Steg 33, wie dies in Figur 4 durch einen mit einer gestrichelten Linie dargestellten Strahl 41' und in Figur 5 mit dem unteren Strahlquerschnitt mit Strahlschwerpunkt D dargestellt ist.

10 Um diese Abweichung von der vorbestimmten Bahn 49 zu erfassen, ist auf den von der Membranschicht 37 abgewandten Stirnseite der Stege 33 jeweils eine Markierungsschicht 61 angeordnet. Diese Markierungsschicht 61 ist aus einem Material gebildet, welches von den für die Membranschicht 37,
 15 die Streubereiche 39 und die Stege 33 verwendeten Materialien verschieden ist und bei Wechselwirkung mit den Elektronen des Projektionsstrahls eine charakteristische Röntgenstrahlung 63 erzeugt. Diese Röntgenstrahlung 63 wird von einem Röntgendetektor 65 erfasst. Der Ausgang des Röntgendetektors
 20 65 ist mit einem in der Steuereinrichtung 58 vorgesehenen Energieanalysator 67 verbunden, der das Ausgangssignal des Detektors 65 filtert, um die charakteristische Röntgenstrahlung 63 von anderen, gegebenenfalls von dem Detektor 65 erfassten Strahlungskomponenten zu
 25 diskriminieren. Das von dem Energieanalysator 67 ausgegebene Signal ist somit im Wesentlichen proportional zur Zahl der auf die Stege 33 bzw. die Markierungsbereiche 61 treffenden Elektronen des Projektionsstrahls 41 und damit auch in etwa proportional zu der in Figur 5 mit 70 bezeichneten Fläche des
 30 Überlapps zwischen Strahlquerschnitt 43 und Markierungsbereich 61. Dieses Signal wird dem Ablenkgenerator 59 als Messsignal 69 zugeführt. Der Ablenksignalgenerator wertet das Messsignal 69 aus und steuert die elektronenoptische Komponente 57 derart an, dass das Signal
 35 69 minimiert wird, um den Projektionsstrahlquerschnitt 43 auf der vorbestimmten Bahn 49 zu positionieren.

Die Maske 31 kann durch ein Ätzverfahren hergestellt werden, wie es in EP 0 953 876 A2 für eine herkömmliche Maske dargestellt ist. Es wird ein Substrat aus dem Material der Stege 33, 35 auf seiner einen Seite mit dem Material der Membranschicht 37 und auf seiner anderen Seite mit einem Maskenmaterial beschichtet. Das Maskenmaterial wird als ein Gitter ausgebildet, das der Geometrie der Stege 33, 35 entspricht. In einem Ätzschritt wird das Substratmaterial in den Gitterzwischenräumen entfernt, so dass das unterhalb der Gittermaske verbleibende Substratmaterial die Stege 33, 35 bildet. Bei geeigneter Wahl des Materials für die Gittermaske kann dieses auf den Stegen 33 verbleiben, um die Streubereiche 61 zu bilden. Es kann das Material der Gittermaske allerdings auch abgetragen werden, woraufhin dann die Stege 33 auf ihrer von der Membranschicht 33 wegweisenden Stirnseiten mit den Markierungsbereichen 61 beschichtet werden.

Als Materialien für den Aufbau der Maske 31 können beispielsweise verwendet werden: Silizium für die Stege 33, 35, Silizium, Siliziumnitrid, Siliziumcarbid und Diamant für die Membranschicht 37, Titan, Chrom, Aluminium und Wolfram sowie deren Oxide und Legierungen davon für die Streubereiche 39. Für die Markierungsbereiche 61 kommen als schwere Elemente, welches insbesondere bezüglich ihres Röntgenspektrums von den für die Streubereiche 39 verwendeten Materialien unterscheidbar sind, Iridium, Platin, Gold und Blei sowie deren Oxide sowie als mittelschweres Element Germanium und dessen Zusammensetzungen in Betracht. Ferner sind für die Markierungsbereiche 61 leichte Materialien bevorzugt, da diese allgemein Elektronen nicht so stark streuen. Insbesondere sind hierbei Elemente bevorzugt, welche bei der Fertigung des Produkts, für welche die Belichtung mit den geladenen Teilchen eingesetzt wird, verträglich sind. Bei der Fertigung von Halbleitern auf Siliziumbasis ist hierbei

insbesondere Germanium als Material für die Markierungsbereiche 61 bevorzugt. Ferner sind für die Markierungsbereiche 61 Materialien bevorzugt, welche durch Bestrahlung mit den geladenen Teilchen zur Szintillation angeregt werden. Derartige Materialien sind bekannt, beispielsweise zur Beschichtung von Sichtschirmen bei Transmissionselektronenmikroskopen, wie beispielsweise Phosphore. Als weitere Materialien für die Markierungsbereiche sind ebenfalls Aluminium, Titan, Vanadium und Germanium bevorzugt, die insbesondere bezüglich eines Detektor-Nachweises über Auger-Elektronen Vorteile aufweisen. Selbstverständlich sind auch andere Materialien und Materialkombinationen für die Herstellung der Maskenkomponenten denkbar.

Im Folgenden werden Varianten der vorangehend dargestellten Ausführungsformen der Erfindung erläutert. Hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Funktion einander entsprechende Komponenten sind mit den für die Figuren 2, 3, 4 und 5 verwendeten Bezugszahlen, zur Unterscheidung jedoch jeweils mit einem zusätzlichen Buchstaben versehen. Zur Erläuterung wird jeweils auf die gesamte vorangehende Beschreibung Bezug genommen.

In Figur 7 ist eine Variante der in Figur 4 dargestellten Maske gezeigt. Die in Figur 7 gezeigte Maske 31a unterscheidet sich von der in Figur 4 dargestellten Maske dadurch, dass Markierungsbereiche 61a zwischen Stegen 33a und einer Membranschicht 37a angeordnet sind. Die Maske 31a kann durch Abwandlung des für die Maske der Figur 4 geschilderten Herstellungsverfahrens gefertigt werden. Bei einem solchen Verfahren wird nämlich vorteilhafterweise vor dem Aufbringen der Membranschicht auf das Substrat aus dem Stegmaterial auf dieses Substrat eine Ätz-Stopp-Schicht aufgebracht. Dieses dient dazu, dass beim Ätzen der Stege 33a aus dem Substrat nicht die Membranschicht durch den Ätzborgang beschädigt

wird. Die Ätz-Stopp-Schicht wird nach dem Herausätzen der Stege 33a in einem separaten Schritt entfernt, so dass zwischen den Stegen 33a die Membranschicht 37a freiliegt. Unter den Stegen 33a und der Membranschicht 37a ist das Material der Ätz-Stopp-Schicht allerdings durch die Stege 33a geschützt und bleibt somit bestehen. Bei geeigneter Wahl des Materials für die Ätz-Stopp-Schicht kann dieses verbleibende Material dann als Material für die Markierungsbereiche dienen, wenn es sich hinsichtlich seiner Wechselwirkung mit den Elektronen von den Materialien für die Membranschicht 37a, die Stege 33a und Streubereiche 39a unterscheidet.

Die in Figur 6 dargestellte Ausführungsform der Erfindung weist wiederum einen Projektionsstrahlquerschnitt 43b auf, der aus einem rechteckigen zentralen Bereich 45b und zwei an gegenüberliegenden Seiten des zentralen Bereichs 45b angeordnete dreieckige Bereiche 47b gebildet ist. Der Abstand der Spitzen der dreieckigen Bereiche 47b ist wiederum so gewählt, dass er einer lichten Weite zwischen benachbarten Stegen 33b entspricht. Bei dem in Figur 6 dargestellten oberen Projektionsstrahlquerschnitt 43b mit am Punkt O angeordnetem Strahlschwerpunkt auf der vorbestimmten Bahn 49b treffen somit keine Elektronen des Projektionsstrahlquerschnitts 43b auf die Stege 33b.

Der Elektronenstrahl der Figur 6 umfasst allerdings zwei Positionierungshilfsstrahlen 75, welche beidseits außerhalb des Projektionsstrahls 43b angeordnet sind. Die Positionierungshilfsstrahlen 75 können beispielsweise durch die in Figur 4 schematisch dargestellte Blendenvorrichtung 45 gemeinsam mit dem Projektionsstrahl 43b geformt werden. Diese Hilfsstrahlen 75 wirken mit Markierungsbereichen 61b zusammen, welche jeweils mittig auf den Stegen 33b angeordnet sind und eine Breite e aufweisen, die geringer ist als die Breite c der Stege 33b von beispielsweise 200 μm . Bei auf der vorbestimmten Bahn mit Strahlschwerpunkt am Ort O

angeordnetem Projektionsstrahlquerschnitt 43b treffen die Hilfsstrahlen 75 auf den Bereich der Stirnseiten der Stege 33b, welche nicht von dem Markierungsbereich 61b bedeckt sind.

5

Weicht der Projektionsstrahlquerschnitt allerdings von der vorbestimmten Bahn um eine Strecke Δy ab, wie dies für den in der Figur 6 unteren Projektionsstrahlquerschnitt 43b mit Strahlschwerpunkt D dargestellt ist, so trifft der in der

10 Figur 6 rechte Hilfsstrahl 75 auf den Markierungsbereich 61b. Dies führt zu einer Wechselwirkung der Elektronen des Hilfsstrahls 75 mit dem Material des Markierungsbereichs 61b, welche Wechselwirkung von einem wie in Figur 4 dargestellten Sensor erfasst werden kann, um über eine Elektronenoptik die

15 Position des Projektionsstrahlquerschnitts zu korrigieren. Die Korrektur erfolgt dabei derart, dass das Messsignal des Sensors minimiert wird, d.h. derart, dass keine Elektronen der Hilfsstrahlen 75 auf die Markierungsbereiche 61b fallen.

20 Eine für die Ausführungsform der Figur 6 verwendbare Maske 31b ist in Figur 8 im Querschnitt dargestellt. Die Maske 31b der Figur 8 ist der in Figur 4 dargestellten Maske ähnlich, allerdings mit dem Unterschied, dass die Markierungsbereiche 61b nicht die gesamte Stirnfläche der Stege 33b bedecken. Die

25 Maske 31b kann in einem zur Fertigung der Maske der Figur 4 ähnlichen Verfahren hergestellt werden, wobei allerdings in beispielsweise einem weiteren Ätzschritt das zur Bildung des Markierungsbereichs 61b verwendete Material derart abgetragen wird, dass die Markierungsbereiche 61b mit ihrer Breite e be-

30 stehen bleiben.

Eine weitere Ausführungsform für eine Maske 31c mit Markierungsbereichen 61c, deren Breite e geringer ist als eine Breite c von Stegen 33c, ist in Figur 9 gezeigt. Diese Maske

35 ist ebenfalls in einem für die Fertigung der in Figur 4 dargestellten Maske verwendeten Verfahren herstellbar, wobei

in einem zusätzlichen Schritt die Markierungsbereiche 61c auf der Membranschicht 37c abgeschieden werden.

In Figur 10 ist eine Variante der in Figur 6 dargestellten Ausführungsform gezeigt. Auch hier weist ein Projektionsstrahlquerschnitt 43d eine Gestalt derart auf, dass Spitzen von Dreiecken 47b bei ordnungsgemäßer Positionierung des Strahlschwerpunkts O auf einer vorbestimmten Bahn 49d Stege 33d der Maske nicht berühren. Es sind ebenfalls Markierungsbereiche 61d vorgesehen, welche in Projektion in Strahlrichtung mit ihrer Breite e nur einen Teil der Breite c der Stege 33d abdecken.

Ein Positionierungshilfsstrahl mit seinem Hilfsstrahlquerschnitt 75d in Maskenebene ist bezüglich dem Projektionsstrahlquerschnitt 43d derart angeordnet, dass bei ordnungsgemäß positioniertem Projektionsstrahlquerschnitt 43d ein Teil des Hilfsstrahls 75d auf den Markierungsbereich 61d trifft. Dies führt zu einer Wechselwirkung von Elektronen des Hilfsstrahls 75d mit dem Material des Markierungsbereichs 61d, welche von dem Sensor erfasst wird und über den Energieanalysator als Soll-Messsignal dem Ablenssignalgenerator zugeführt wird.

Der Hilfsstrahlquerschnitt 75d weist eine dreieckige Gestalt derart auf, dass sich sein Querschnitt 75d in eine Richtung quer zur Erstreckungsrichtung der Stege 33d verjüngt. Folglich ändert sich bei einer Abweichung des Projektionsstrahlschwerpunkts vom Punkt O die Fläche, mit der der Hilfsstrahl 75d auf den Markierungsbereich 61d trifft, wie dies aus der in die Figur 10 integrierte Vergrößerungsdarstellung deutlich wird: die Zahl der Wechselwirkungen ist proportional zu der Fläche, mit der der Hilfsstrahlquerschnitt 75d den Markierungsbereich 61b überlappt, wobei für diese Fläche F gilt: $F = d^2 \times \tan \alpha$, wo-

bei der Öffnungswinkel der Dreiecksgestalt des Hilfsstrahls 75d gleich 2α ist.

Der Ablenkgenerator wertet das entstehende Messsignal aus und steuert dann die elektronenoptische Komponente (Bezugszeichen 57 in Figur 4) derart an, daß das Messsignal auf einem vorbestimmten Wert gehalten wird, um den Projektionsstrahlquerschnitt 73d auf der vorbestimmten Bahn 49d zu positionieren.

In Figur 11 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Diese ist der in Figur 10 gezeigten Ausführungsform sehr ähnlich, allerdings wird hier ein Markierungsbereich 61e zusammen mit einem Positionierungshilfsstrahl 75e nicht nur zur Positionierung des Strahlschwerpunkts O des Projektionsstrahlquerschnitts 43e auf einer vorbestimmten Bahn 49e verwendet. Hilfsstrahl 75e und Markierungsbereich 61e werden hier weiterhin dazu verwendet, um das Erreichen des Endpunkts 53e (vgl. Figur 3) bei der Bewegung des Projektionsstrahls 43e entlang der vorbestimmten Bahn 49e zu bestimmen.

Der Endpunkt 53e ist mit einem Abstand g von einem Quersteg 35e angeordnet, der dem Abstand des Strahlschwerpunkts O von einer Vorderfront 77 des Projektionsstrahlquerschnitts 43e entspricht.

Der Markierungsbereich 61e erstreckt sich entlang des Stegs 33e in Richtung zu dem Quersteg 35e hin, endet allerdings mit einem Abstand vor dem Steg 35e, der ebenfalls dem Abstand e entspricht, derart, dass bei Anordnung des Projektionsstrahlschwerpunkts O auf dem Endpunkt 53e gerade kein Überlapp zwischen dem Hilfsstrahl 75e und dem Markierungsbereich 61e stattfindet. Entsprechend ist die Zahl der Wechselwirkungen zwischen den Elektronen des Hilfsstrahls 75e und dem Markierungsbereich 61e auf null abgesunken, was

über den Sensor erfasst werden kann und unter anderem als Signal dafür eingesetzt werden kann, um den Projektionsstrahl an einem Endpunkt 53e seiner vorbestimmten Bahn 49e abzuschalten.

5

Eine der Ausführungsform der Figur 11 ähnliche weitere Ausführungsform der Erfindung ist in Figur 12 dargestellt.

10

15

Hier sind neben einem Projektionsstrahl 43f zwei beidseits desselben angeordnete Positionierungshilfsstrahlen 75f vorgesehen. Die Positionierungshilfsstrahlen 75f laufen während der Bewegung des Projektionsstrahls 43f auf der vorbestimmten Bahn 49f auf Markierungsstreifen 61f, um über die Wechselwirkung der Elektronen des Hilfsstrahls 75f mit dem Markierungsstreifen 61f den Strahlschwerpunkt O auf der vorbestimmten Bahn 49f, wie vorangehend beschrieben, zu positionieren.

20

25

30

An den an Querstege 35f angrenzenden Enden der Stege 33f sind jeweils Endmarkierungen 79 derart angebracht, dass diese von den Hilfsstrahlen 75f getroffen werden, sobald sich der Strahlschwerpunkt O dem Endpunkt 53f annähert. Die Endmarkierungen 79f sind aus einem Material gebildet, dessen Wechselwirkung mit dem Elektronenstrahl sich von der Wechselwirkung mit den Materialien unterscheidet, wie sie für die Bildung der Stege 33f, 35f, die Membranschicht, die Streubereiche und die Markierungsschicht 61f verwendet werden. Allerdings ist auch diese Wechselwirkung von dem Sensor oder einem separat hierfür vorgesehenen Sensor nachweisbar, so dass das Erreichen der Endposition 53f ähnlich wie bei der in Figur 11 dargestellten Ausführungsform erfasst werden kann.

35

In Figur 13 ist eine Variante der in Figur 5 dargestellten Ausführungsform gezeigt. Im Unterschied zu der Ausführungsform der Figur 5 ist hier ein Markierungsbereich

61g nicht in Projektion über einen Steg 33g angeordnet, sondern im Bereich zwischen benachbarten Stegen 33g, und zwar derart, daß ein Projektionsstrahlquerschnitt 43e mit ordnungsgemäß auf einer vorbestimmten Bahn 49g positioniertem Strahlschwerpunkt O mit seinem sich quer zur Erstreckungsrichtung der Bahn 49g verjüngenden Teil, daß heißt, mit seinem dreieckigen Bereich 47g, mit dem Markierungsstreifen 61g überlappt. Die Fläche der Überlappung ist hierbei abhängig von einer Abweichung Δy des Strahlschwerpunktes O von der vorbestimmten Bahn 49g und vergrößert sich, wie dies in Figur 13 durch den unteren Strahlquerschnitt mit Schwerpunkt D dargestellt ist, wenn dieser nach rechts von der vorbestimmten Bahn abweicht. Mit Änderung der Überlappungsfläche ändert sich auch die Anzahl der Wechselwirkungen zwischen den Elektronen des Strahls mit dem Material des Markierungsbereichs 61g, was über den Sensor erfaßt wird und zur Korrektur der Bahn des Strahlquerschnitts verwendet wird.

Da bei diesem Ausführungsbeispiel der Markierungsbereich zwischen den Stegen angeordnet ist, daß heißt in einem Bereich, welcher für die Bildung des Musters der Maske durch Streubereiche (Bezugszeichen 39 in Figur 4) verwendet wird, ist hier darauf zu achten, daß die Streuung der Elektronen durch das Material des Markierungsbereichs 61g so gering ist, daß eine Störung der Abbildung des Musters auf das Substrat weitgehend vermieden ist. Allerdings erfolgen dennoch ausreichend viele Wechselwirkungen, die über den Sensor erfaßbar sind, um die Korrektur der Strahlführung, wie vorangehend beschrieben, durchzuführen.

Als weitere Ausführungsform der Erfindung ist es möglich, für die beiden in Figur 5 dargestellten Markierungsbereiche 61 verschiedene Materialien vorzusehen, die sich hinsichtlich ihrer Wechselwirkung mit den Elektronenstrahlen unterscheiden. Dadurch kann über einen geeigneten Sensor oder

ein Paar von Sensoren festgestellt werden, ob der Strahlschwerpunkt des Projektionsstrahls 43 nach rechts oder nach links von seiner vorbestimmten Bahn 49 abweicht. Eine derartige Maske ist herstellbar, indem für die Stege 33 die
 5 beiden Materialien abwechselnd verwendet werden, also jeder zweite Steg aus dem selben Material gebildet ist.

Eine weitere Variante der in Figur 4 dargestellten Maske kann dadurch gefertigt werden, daß das Markierungsmaterial dem für
 10 die Stege verwendeten Material zugesetzt ist beispielsweise durch das Dotieren oder Implantieren. Damit bilden die Stege selbst die Markierungsbereiche.

In Figur 14 ist eine weitere Variante der in den Figuren 4,
 15 7, 8 und 9 dargestellten Masken schematisch gezeigt. Die in Figur 14 gezeigte Maske 31h unterscheidet sich von den in den vorangehenden Figuren gezeigten Masken im Wesentlichen dadurch, dass ein Markierungsbereich 61h, gesehen in Projektion in Strahlrichtung, nicht mit einem Steg 33h
 20 überlappt, sondern neben diesem auf einer Membranschicht 37h angeordnet ist.

Hierbei wird vorzugsweise als ein Bereich der durch geladene
 25 Teilchen auf die zu belichtende Schicht abgebildet wird, der Bereich zwischen benachbarten Markierungsbereichen 61h verwendet, also ein Bereich, der eine der lichten Weite zwischen den in Figur 14 dargestellten Markierungsbereichen 61h entsprechende oder geringere Breite aufweist.

Diese Maske kann zusammen mit Projektionsstrahlquerschnitten
 30 verwendet werden, wie sie vorangehend beschrieben wurden. Insbesondere kann eine Abstimmung zwischen den Markierungsbereichen 61h und dem Projektionsstrahlquerschnitt eingesetzt werden, wie sie in Zusammenhang mit Figur 5
 35 erläutert wurde. Dort weist der Projektionsstrahlquerschnitt eine Breite auf, die der lichten Weite zwischen den

Markierungsbereichen 61h entspricht. Die Strahlführung erfolgt dann derart, dass der Detektor 65 der Figur 4 ein Detektionssignal von im wesentlichen Null erfasst, wenn der Projektionsstrahlquerschnitt in seiner Sollposition bezüglich der Maske angeordnet ist.

Die Abstimmung des Projektionsstrahlquerschnitts auf die Maske der Figur 14 kann allerdings auch in der in Zusammenhang mit Figur 6 erläuterten Weise erfolgen, wobei der Projektionsstrahlquerschnitt seitlich angeordnete Hilfsstrahlen aufweist, die zur Erzeugung des Signals für den Detektor 65 vorgesehen sind und wobei die Strahlführung dann vorzugsweise derart erfolgt, dass das von dem Detektor 65 erzeugte Messsignal auf einem vorbestimmten konstanten Wert gehalten wird.

Ferner kann die Abstimmung auch derart erfolgen, wie dies im Zusammenhang mit Figur 13 erläutert wurde, wobei der Projektionsstrahlquerschnitt mit seinen sich seitlich verjüngenden Bereichen auf die Markierungsbereiche 61h fällt und wiederum die Strahlführung derart erfolgt, dass das Detektionssignal des Detektors 65 auf einem vorbestimmten konstanten Wert gehalten wird.

Ferner ist auch vorgesehen, dass für jeweils benachbarte Markierungsbereiche 61h der Figur 14 unterschiedliche Materialien eingesetzt werden, um eine Abweichung der Strahlführung in die eine oder andere Richtung mittels Detektoren erfassen zu können.

Die Maske 31h der Figur 14 weist ferner Maskierungsbereiche 81 auf, welche, gesehen in Projektion parallel zum Teilchenstrahl, mit den Markierungsbereichen 61h überlappen. Die in Figur 14 dargestellten Maskierungsbereich 81 erstrecken sich sogar in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl über die Markierungsbereiche 61h hinaus und

überlappen auch mit den Stegen 83h. Die Maskierungsbereiche 81 haben die Aufgabe, geladene Teilchen, welche durch die Markierungsbereiche 61h oder die Stege 63h nicht oder geringfügig gestreut wurden, soweit zerstreuen, dass sie nicht auf die zu belichtende Schicht abgebildet werden, wie dies für den Strahl 13 in Figur 1 erläutert wurde.

Hierzu wird für die Maskierungsschicht 81 das gleiche Material verwendet, wie für Streubereiche 39h auf der Membran 37h.

Die Maskierungsbereiche 81 und die Streubereiche 39h können in einem gemeinsamen Fertigungsschritt geformt werden, wie dies für die Streubereiche in den vorangehend beschriebenen Ausführungsbeispiel bereits erläutert wurde.

Bei den vorangehend insbesondere in Zusammenhang mit den Figuren 4, 7, 8, 9 und 14 beschriebenen Masken sind die Stege bezüglich der Membranschicht jeweils auf der der Strahlformungsrichtung zuweisenden Seite angebracht. Es ist jedoch gleichfalls möglich, die Stege bezüglich der Membranschicht auf der entgegengesetzten Seite, das heißt der von der Strahlformungsrichtung wegweisenden Seite, anzuordnen.

Ferner ist es möglich, die Markierungsbereiche auf der der Strahlformungsrichtung zuweisenden Seite des Stützstegs oder auf der Membranschicht selbst anzuordnen. Hierbei wiederum ist vorgesehen, dass die Markierungsschicht zwischen Membranschicht und Stützsteg angeordnet ist, wie dies insbesondere im Zusammenhang mit Figur 7 erläutert wurde, oder es ist vorgesehen, dass die Markierungsschicht auf der Membranschicht auf der dem Stützsteg gegenüberliegenden Seite angeordnet ist, wie dies insbesondere im Zusammenhang mit Figur 9 erläutert wurde.

Ferner ist es möglich, dass die Markierungsschicht, gesehen in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl, mit der Grundfläche des Stegs überlappt, wobei die Markierungsbereiche sich über die gesamte Breite des Stützstegs erstrecken können, wie dies insbesondere in Zusammenhang mit den Figuren 4 und 7 erläutert wurde, oder wobei die Markierungsbereiche eine Breite aufweisen, die geringer ist als die Breite der Stützstege, wie dies insbesondere in Zusammenhang mit den Figuren 8 und 9 erläutert wurde.

Ferner können die Markierungsbereiche, in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl auch neben dem Stützsteg angeordnet sein, und zwar mit Abstand von diesem, wie dies besonders in Zusammenhang mit Figur 13 erläutert wurde, oder direkt angrenzend an diesem, wie dies in Zusammenhang mit Figur 14 erläutert wurde.

Bei den in den Figuren 4, 7, 8 und 9 dargestellten Ausführungsformen sind die Streubereiche auf der der Strahlformungseinrichtung zugewandten Seite der Membranschicht angeordnet. Es ist bei diesen Ausführungsformen alternativ möglich, die Streubereiche auch auf der von der Strahlformungseinrichtung wegweisenden Seite der Membranschicht anzuordnen, wie dies in Zusammenhang mit Figur 14 dargelegt wurde. Umgekehrt ist es auch möglich, bei der in Figur 14 dargestellten Ausführungsform die Streubereiche auf der der Strahlformungseinrichtung zuweisenden Seite der Membranschicht anzuordnen.

Ferner ist es, je nach konkret gewählter Ausführungsform, ebenfalls möglich, die Streubereiche auf der Membranschicht auf der gleichen Seite wie die Stege oder auf der jeweils entgegengesetzten Seite anzuordnen.

Bei den meisten der vorangehend beschriebenen Ausführungsformen weisen die Spitzen der dreieckigen Bereiche in der Maskenebene einen Abstand voneinander auf, der der lichten Weite zwischen benachbarten Stegen entspricht.

- 5 Allerdings ist es ohne weiteres auch möglich, für den Abstand der Spitzen voneinander, d. h. für die Strahlbreite, einen geringeren Wert zu wählen.

Zeiss

Z 8435-DE

5

Patentansprüche

1. Projektionsvorrichtung zum Abbilden eines Musters einer Maske (31) auf ein mit einer strahlungsempfindlichen Schicht versehenes Substrat mittels eines Strahls projizierter geladener Teilchen,

10

wobei die Maske (31) aufweist:

- eine Membranschicht (37) aus einem ersten Material,
- das Muster bildende Streubereiche (39) aus einem die geladenen Teilchen stärker als die Membranschicht (37) streuenden zweiten Material und
- eine Mehrzahl von sich geradlinig erstreckenden, mit Abstand voneinander angeordneten und die Membranschicht (37) samt der Streubereiche (39) tragenden Stützstegen (33),

15

20

und wobei die Projektionsvorrichtung umfaßt:

- eine Strahlformungseinrichtung (45) zum Erzeugen des Projektionsstrahls mit einem vorbestimmten Projektionsstrahlquerschnitt (45) in der Maskenebene,
- eine Positionier-Bewegungseinrichtung (57,55), um den Projektionsstrahlquerschnitt (45) in der Maskenebene entlang einer vorbestimmten Bahn (49) parallel zu der Erstreckungsrichtung der Stege (33) über die Maske (31) zu bewegen,

25

30

dadurch gekennzeichnet, daß ein Sensor (65) zur Abgabe eines Meßsignals (69) vorgesehen ist, welches von der Anzahl der geladenen Teilchen abhängt, die einen an der

35

Maske (31) vorgesehenen Markierungsbereich (61) treffen.

2. Projektionsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Positionier-Bewegungseinrichtung (57) auf das Meßsignal (69) anspricht, um Abweichungen Δy von der vorbestimmten Bahn (49) zu reduzieren.

3. Projektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei der Projektionsstrahlquerschnitt (43) in Richtung quer zu der Erstreckungsrichtung der Stege (33) eine Breite aufweist, die im wesentlichen der lichten Weite (d) zwischen benachbarten Stegen (33) entspricht.

4. Projektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Strahlformungseinrichtung ferner wenigstens einen zur Wechselwirkung mit dem Markierungsbereich (61) auf der Maske vorgesehenen Positionierungshilfsstrahl erzeugt, dessen Hilfsstrahlquerschnitt (75) in der Maskenebene bezüglich dem Projektionsstrahlquerschnitt (43) mit vorbestimmtem konstanten Abstand angeordnet ist.

5. Projektionsvorrichtung nach Anspruch 4, wobei der Hilfsstrahlquerschnitt (75) sich in eine Richtung quer zu einer Erstreckungsrichtung der Bahn (49) des Strahls kontinuierlich verjüngt.

6. Projektionsvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Strahlformungseinrichtung zwei Positionierungshilfsstrahlen (75) erzeugt, deren Hilfsstrahlquerschnitte in der Maskenebene in Richtung quer zu der Erstreckungsrichtung der Stege (33b) mit einem lichten Abstand voneinander angeordnet sind, der

größer ist als die lichte Weite zwischen benachbarten Stegen (33b).

7. Projektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Positionier-Bewegungseinrichtung (57) die Bahn des Projektionsstrahlquerschnitts (43) derart steuert, daß die Anzahl der den Markierungsbereich (61) treffenden geladenen Teilchen minimiert ist.

8. Projektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Positionier-Bewegungseinrichtung (57) die Bahn des Projektionsstrahlquerschnitts (43) derart steuert, daß die Anzahl der die Markierungsbereiche (61) treffenden geladenen Teilchen einem vorbestimmten Wert entspricht.

9. Projektionsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Positionier-Bewegungseinrichtung (58) auf das Meßsignal anspricht, um die Bewegung des Projektionsstrahlquerschnitts (43) entlang der Bahn (49) zu beenden.

10. Maske für eine Projektionsvorrichtung zum Abbilden eines Musters der Maske auf ein mit einer strahlungsempfindlichen Schicht versehenes Substrat mittels eines Strahls projizierter geladener Teilchen, wobei die Maske (31) umfaßt:

- eine Membranschicht (37) aus einem ersten Material,
- das Muster bildende Streubereiche (39) aus einem die geladenen Teilchen stärker als die Membranschicht (37) streuenden zweiten Material und
- eine Mehrzahl von mit Abstand voneinander angeordneten und die Membranschicht (37) samt der Streubereiche (39) tragenden Stützstegen (33),

gekennzeichnet durch wenigstens einen durch ein Markierungsmaterial gebildeten Markierungsbereich (61), wobei sich das Markierungsmaterial hinsichtlich seiner Wechselwirkung mit den geladenen Teilchen von dem ersten und dem zweiten Material unterscheidet und diese Wechselwirkung mittels eines Sensors (65) nachweisbar ist.

11. Maske nach Anspruch 10, wobei das Markierungsmaterial eine andere Streuwirkung oder/und eine andere Reflexionswirkung oder/und eine andere Absorptionswirkung für die geladenen Teilchen aufweist als das erste und das zweite Material.

12. Maske nach Anspruch 10 oder 11, wobei die Wechselwirkung mittels eines Auger-Elektronendetektors oder/und eines Rückstreuелеktronendetektors oder/und eines Röntgenstrahlungsdetektors (65) oder/und eines Fluoreszenzstrahlungsdetektors nachweisbar ist.

13. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei der Markierungsbereich (61) durch eine auf eine von der Membranschicht (37) abgewandten Stirnseite des Stegs (33) aufgebrachte Schicht aus dem dritten Material gebildet ist.

14. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei der Markierungsbereich (61a) durch eine zwischen der Membranschicht (37a) und dem Steg (33) angeordnete Markierungsschicht aus dem dritten Material gebildet ist.

15. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei der Markierungsbereich (61c) durch eine auf der dem Steg (33c) abgewandten Seite der Membranschicht (37c)

angeordnete Markierungsschicht aus dem dritten Material gebildet ist.

- 5 16. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 15, wobei sich der Markierungsbereich (61) parallel zu einem diesem zugeordneten Steg (33) erstreckt.
- 10 17. Maske nach Anspruch 16, wobei der Markierungsbereich (61) durch den Steg (33) gebildet ist.
- 15 18. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 17, wobei der Markierungsbereich(33), gesehen in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl(41), mit der projizierten Fläche des Stegs (33) zusammenfällt.
- 20 19. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 18, wobei der Markierungsbereich (61), gesehen in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl (41), innerhalb der projizierten Fläche des Stegs (33) und mit einem vorbestimmten Abstand von deren Rändern angeordnet ist.
- 25 20. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 19, wobei der Markierungsbereich (61g), gesehen in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl, außerhalb der projizierten Fläche des Stegs (33).
- 30 21. Maske nach Anspruch 20, wobei der Markierungsbereich mit einem vorbestimmten Abstand von den Rändern des Stegs angeordnet ist.
- 35 22. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 21, wobei wenigstens ein Maskierungsbereich (81) vorgesehen ist, der, gesehen in Projektion parallel zu dem Teilchenstrahl, mit dem Markierungsbereich (61h) wenigstens teilweise überlappt und der aus einem geladene Teilchen stärker als die Membranschicht (37h)

oder/und das Markierungsmaterial oder/und der Stützsteg (33h) streuenden Material gebildet ist.

23. Maske nach Anspruch 22, wobei das Material des Maskierungsbereichs (81) das Material des Streubereichs 39h umfasst.

24. Maske nach einem der Ansprüche 10 bis 23, wobei das Markierungsmaterial zwei verschiedene Markierungsmaterialien mit unterscheidbarer Wechselwirkung umfaßt, wobei benachbarten Stegen jeweils paarweise verschiedene Markierungsmaterialien zugeordnet sind.

25. Verfahren zur Belichtung einer strahlungsempfindlichen Schicht mittels durch eine Maske projizierter geladener Teilchen, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer Maske gemäß einem der Ansprüche 10 bis 24,
- Bereitstellen einer Projektionsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, und
- Erzeugen des Projektionsstrahls und Bewegen von dessen vorbestimmten Projektionsstrahlquerschnitt in der Maskenebene parallel zur Erstreckungsrichtung der Stege wenigstens in Abhängigkeit von dem Meßsignal derart, daß die Anzahl der die Markierungsbereich treffenden geladenen Teilchen minimiert ist oder einem vorbestimmten Wert entspricht.

26. Verfahren zur Belichtung einer strahlungsempfindlichen Schicht mittels durch eine Maske projizierter geladener Teilchen, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer Maske gemäß einem der Ansprüche 10 bis 24,

- Bereitstellen einer Projektionsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9,
- Erzeugen des Projektionsstrahls und Bewegen von dessen vorbestimmten Projektionsstrahlquerschnitts in der Maskenebene parallel zur Erstreckungsrichtung der Stege, und
- Beenden der Bewegung wenigstens in Abhängigkeit von dem Meßsignal.

5

Zusammenfassung

Es wird eine Projektionsvorrichtung zum Abbilden eines
 5 Musters einer Maske (31) auf ein mit einer
 strahlungsempfindlichen Schicht versehenes Substrat
 mittels eines Strahls projizierter geladener Teilchen
 vorgeschlagen,

10 wobei die Maske (31) aufweist:

- eine Membranschicht (37) aus einem ersten Material,
- das Muster bildende Streubereiche (39) aus einem die
 15 geladenen Teilchen stärker als die Membranschicht
 (37) streuenden zweiten Material und
- eine Mehrzahl von sich geradlinig erstreckenden, mit
 Abstand voneinander angeordneten und die Membran-
 schicht (37) samt der Streubereiche (39) tragenden
 20 Stützstegen (33).

und wobei die Projektionsvorrichtung umfaßt:

- eine Strahlformungseinrichtung (45) zum Erzeugen des
 25 Projektionsstrahls (41) mit einem vorbestimmten
 Projektionsstrahlquerschnitt in der Maskenebene,
- eine Positionier-Bewegungseinrichtung (57,55), um den
 Projektionsstrahlquerschnitt (45) in der Maskenebene
 entlang einer vorbestimmten Bahn parallel zu der Er-
 30 streckungsrichtung der Stege (33) über die Maske (31)
 zu bewegen.

Die Projektionsvorrichtung zeichnet sich dadurch aus,
 35 daß ein Sensor (65) zur Abgabe eines Meßsignals (69)
 vorgesehen ist, welches von der Anzahl der geladenen

Teilchen abhängt, die einen an der Maske (31) vorgesehenen Markierungsbereich (61) treffen.

(Figur 4)

Figur für die Veröffentlichung mit der Zusammenfassung

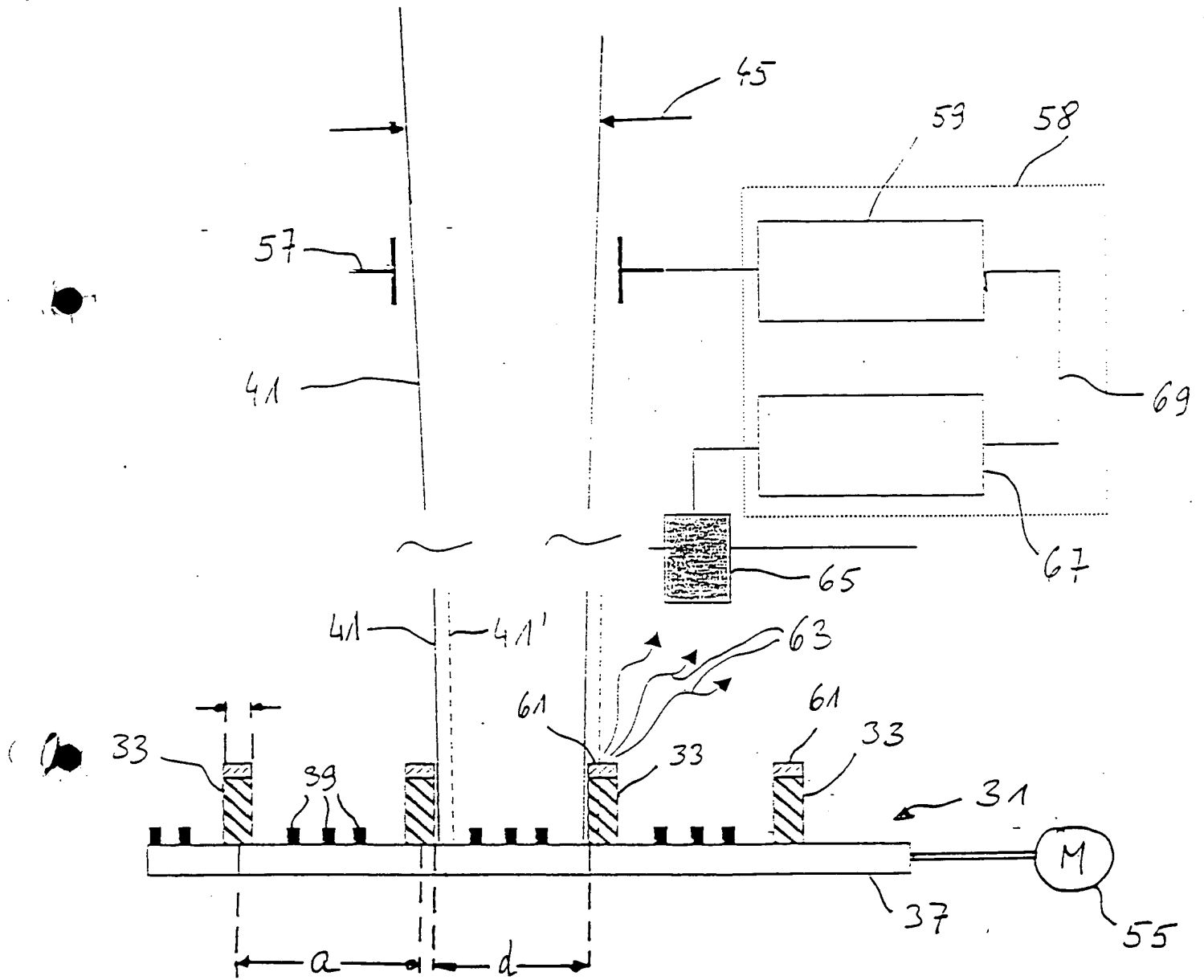


Fig 4

1/9

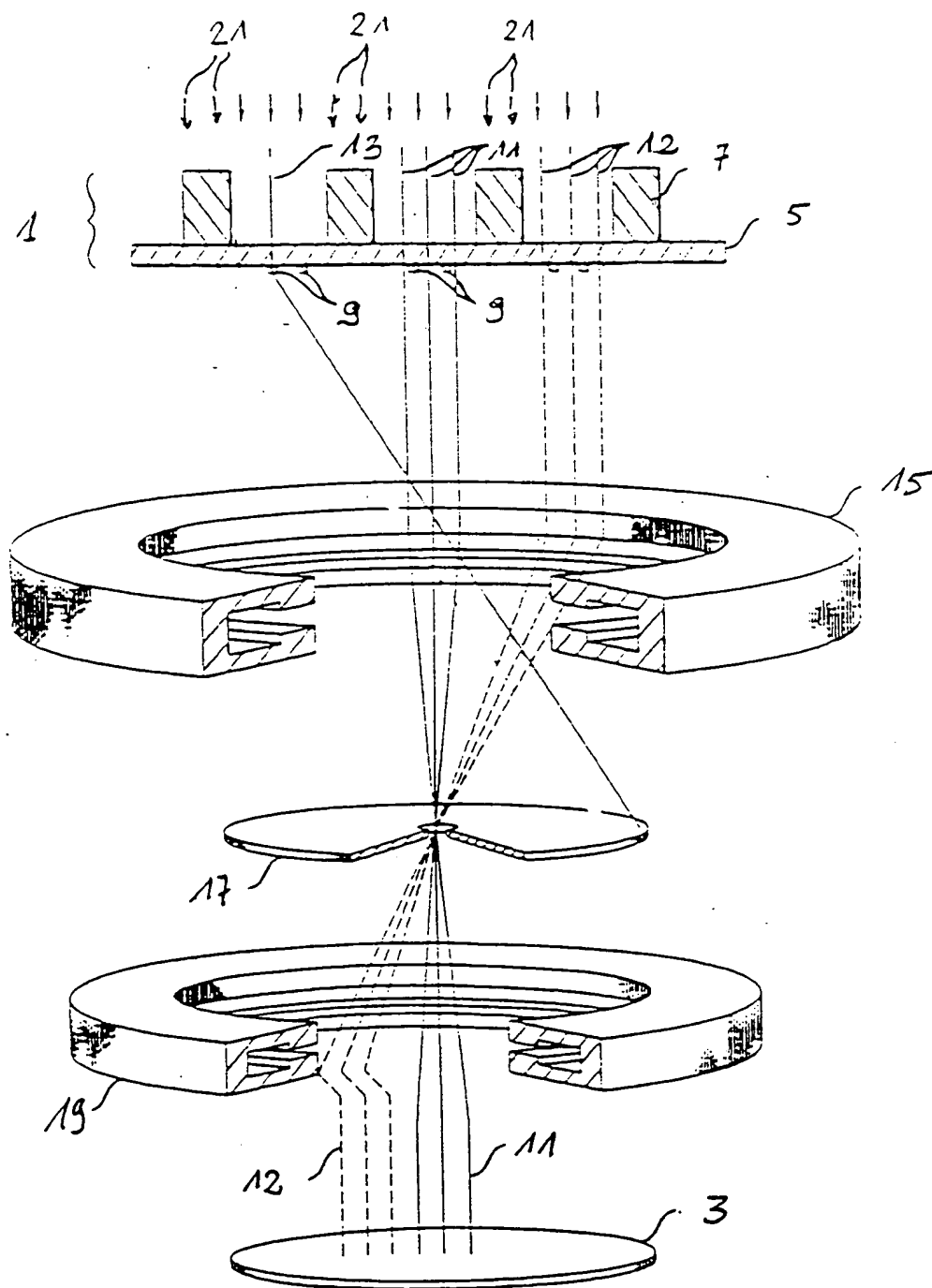


Fig. 1

3/9

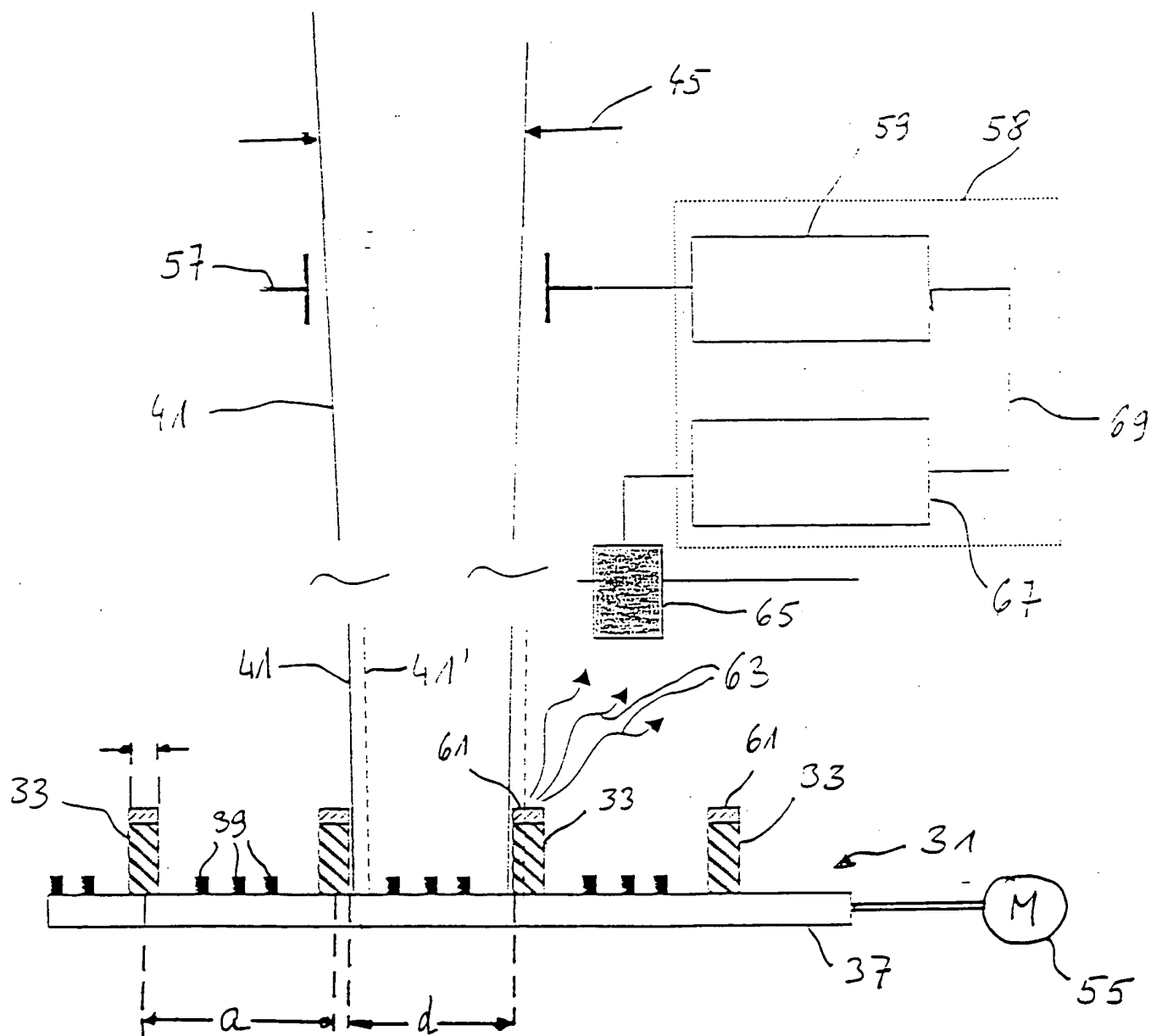


Fig 4

5/g

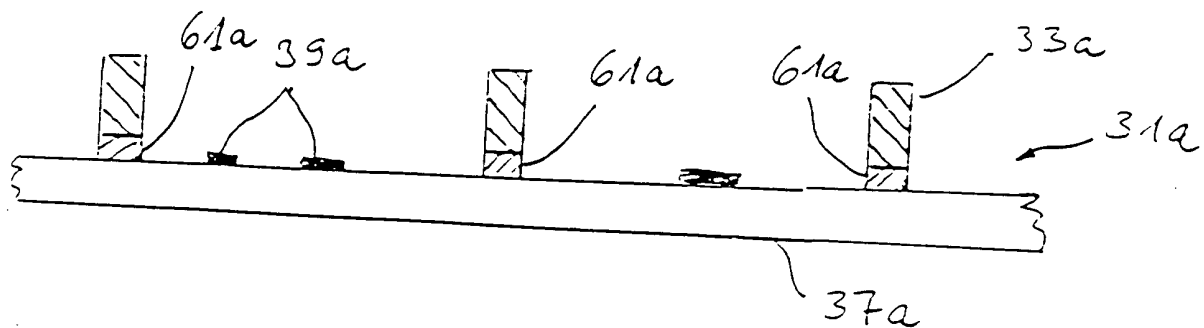


Fig 7

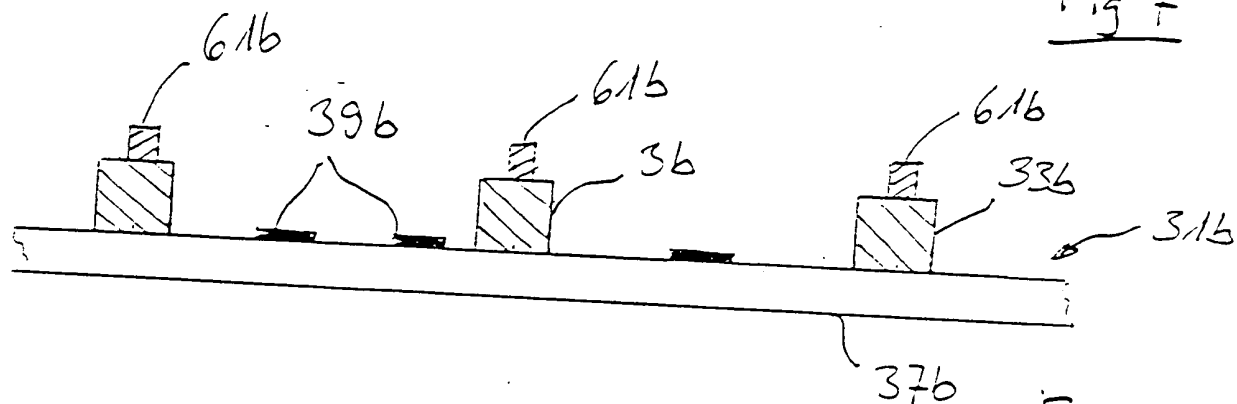


Fig 8

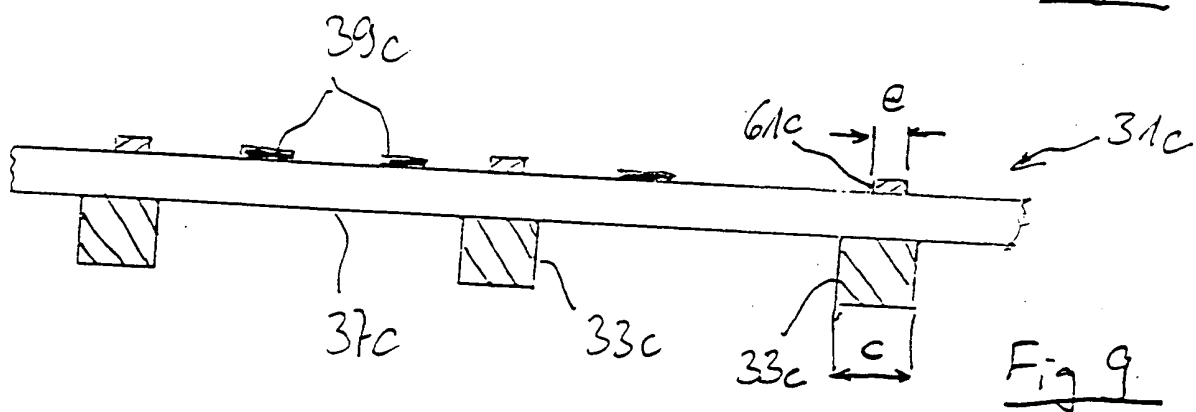


Fig 9

6/9

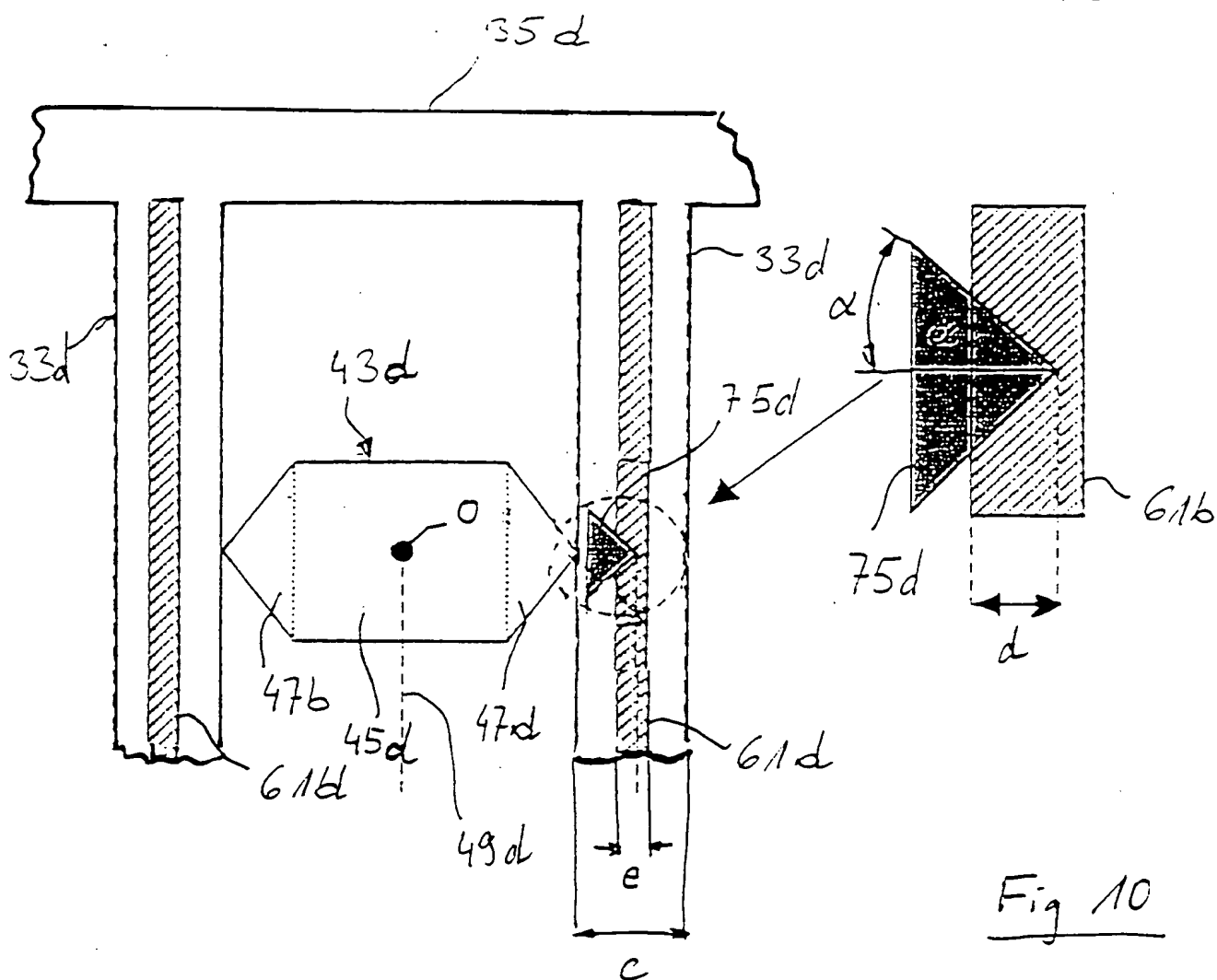


Fig 10

7/9

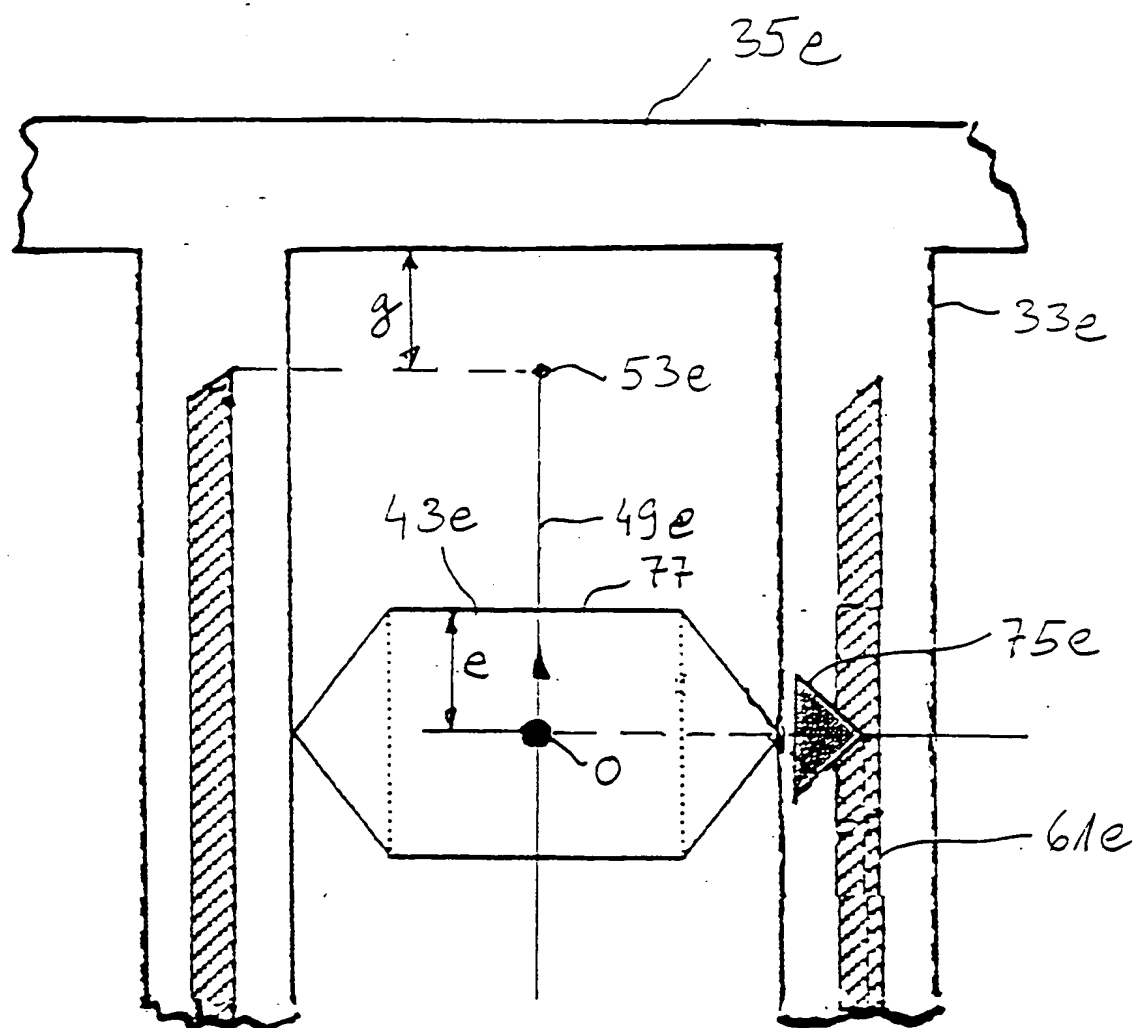


Fig 11

8/9

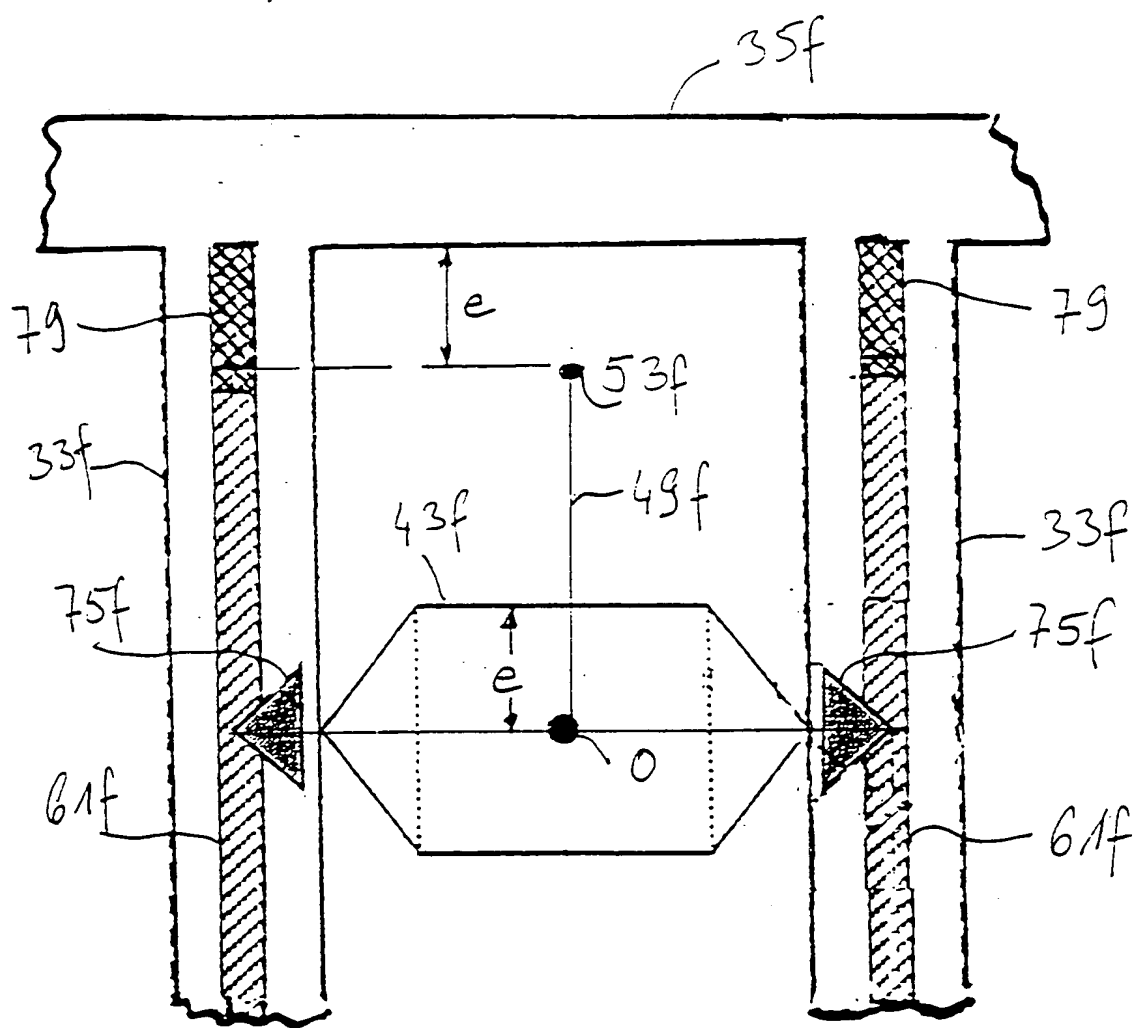


Fig 12

9/9

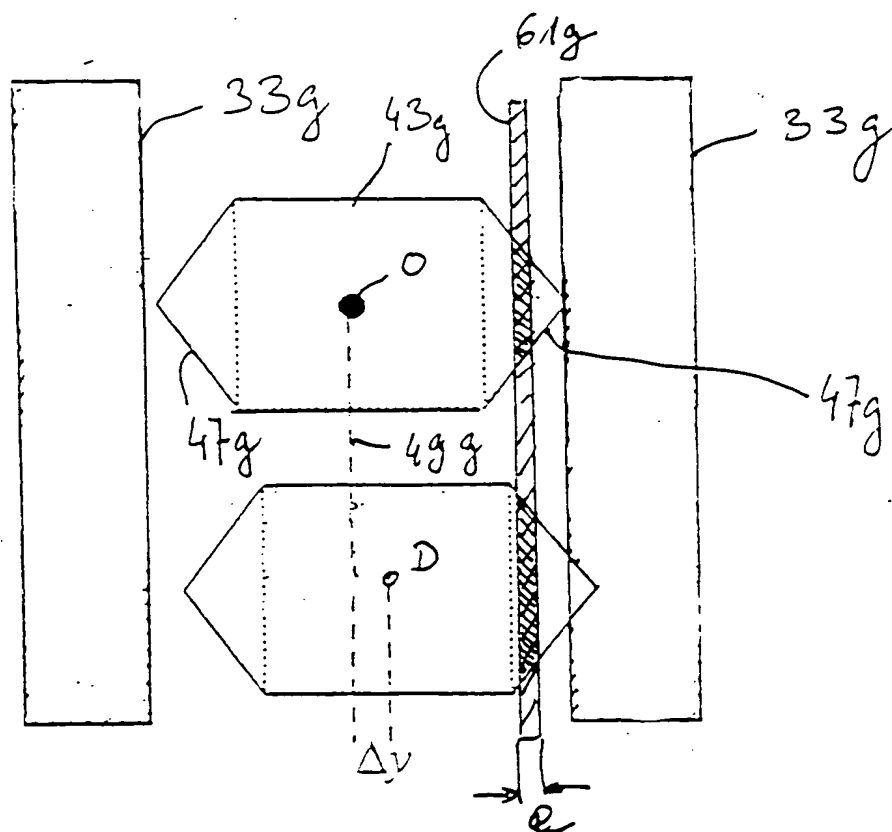


Fig 13

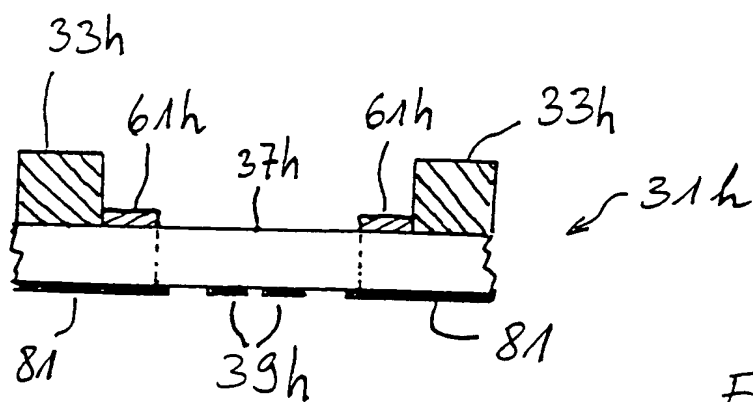


Fig 14